

半 导 体 学 报

第3卷 第4期 1982年7月

目 录

- 硅(111)面 2×1 重构表面和硅(100)面的电子态密度的模型计算 … 傅卓武 (259)
硅单晶中孪生界面的结构和缺陷……………许顺生 杨传铮 姜小龙 (270)
在掺 Si GaAs 单晶中 Ga 小晶面生长区的界区结构状态的研究 …… 蒋四南 (277)
氢气和氩气中区熔生长的中子嬗变掺杂硅退火行为的研究…王正元 林兰英 (282)
 $Pb_{1-x}Sn_xTe$ 闭管汽相输运过程的研究 … 袁诗鑫 谢钦熙 司承才 于梅芳 (290)
氢对氢化无定形硅能隙的影响……………陈治明 陈廷杰 孔光临 林兰英 (297)
热氧化二氧化硅层中氟离子的注入及其分布……………徐至中 梁励芬 (304)
GaAlAs/GaAs DH 激光器的自脉动特性…赵礼庆 王启明 张存善 吴振球 (312)
长基区晶体管的磁敏感效应……………黄得星 (319)
GaAs 化学汽相淀积的热力学分析—— $Ga/AsCl_3/H_2/IG$ 系统 ……陆大成 (329)

研 究 简 报

- 硅(111)晶片外延时图形微畸变的研究 …… 陈明琪 杨传铮 王广福 (337)
扩硼 Si 在连续 CO_2 激光辐照后的特性…李元恒 张玉峰 吴书祥 杜永昌 (340)